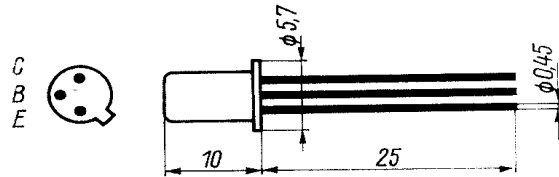


Germanium-pnp-Transistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11 811 für Niederfrequenz mit erhöhter Spannungsfestigkeit.



Masse ca. 0,8 g

Wärmewiderstand	R_{thja}	\leq	0,38 grad/mW
Wärmewiderstand	R_{thjc}	\leq	0,05 grad/mW

Grenzwerte; gültig für den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO}$	$=$	35 V
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CER}$	$=$	33 V
$R_{BE} = 1 k\Omega$			
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$	$=$	15 V
Kollektorstrom	$-I_C$	$=$	250 mA
Basisstrom	$-I_B$	$=$	50 mA
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	$=$	+80 °C
Betriebstemperaturbereich			-25 °C bis +65 °C

Statische Kennwerte

		Min.	Typ	Max.	
Kollektor-Basis-Reststrom	$-I_{CBO}$		9 μ A	18 μ A	Stromverstärkungsgruppe
$-U_{CB}$ = 15 V					
Kollektor-Emitter-Reststrom	$-I_{CER}$			100 μ A	
$-U_{CER}$ = 33 V					
$R_{BE} = 1 k\Omega$					
Emitter-Basis-Reststrom	$-I_{EBO}$		15 μ A	50 μ A	
$-U_{EB}$ = 10 V					
Kollektor-Basis-Stromverhältnis	h_{21E}	18		35	A
$-U_{CE}$ = 0,5 V		28		56	B
$-I_C$ = 100 mA		45		90	C
		71		140	D
h_{21E} -Verhältnis	$\frac{h_{21E 100}}{h_{21E 250}}$			1,3	
$h_{21E 100}$ bei $-I_C = 100$ mA					
$h_{21E 250}$ bei $-I_C = 250$ mA					

Dynamischer Kennwert

Grenzfrequenz	$f_{h_{21e}}$	12 kHz
$-U_{CE}$	$=$	2 V
$-I_C$	$=$	10 mA

Bestellbeispiel für einen Transistor der Stromverstärkungsgruppe B

Transistor GC 122 B

Transistoren in ruhender Luft

1. ohne Kühlblech
2. mit Kühlkörper TGL 200—8420 Form G
3. mit AL-Kühlblech, 2 mm dick, A = 9 cm²
vertikal, blank, unbearbeitet
4. vertikal, blank, unbearbeitet A = 25 cm²
5. vertikal, blank, unbearbeitet A = 100 cm²
6. mit angenähert idealer Kühlung

